

ILGAD TCAD Simulations

Monday 4 June 2018 15:20 (20 minutes)

Where we present TCAD simulations results on the brand new ILGAD device, in two flavours, 300 um and 50 um thickness. Radiation effects in signal formation an particularly in the risign time are considered.

Primary author: Prof. PALOMO PINTO, Fco.Rogelio (Dept. Ingeniería Electrónica, Escuela Técnica Superior de Ingenieros, Universidad de Sevilla)

Co-authors: Dr HIDALGO, Salvador (Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona); Dr VILA, Iván (Instituto de Física de Cantabria)

Presenter: Prof. PALOMO PINTO, Fco.Rogelio (Dept. Ingeniería Electrónica, Escuela Técnica Superior de Ingenieros, Universidad de Sevilla)

Session Classification: Device Simulation